

物理電子システム創造専攻

平成19年度後期修士構想・中間発表会プログラム

発表時間: 構想 12分=発表6分+質疑6分, 中間 15分=発表8分+質疑7分, 博士一貫コース 16分=発表8分+質疑8分

12月20日(木) A会場(G2棟501会議室)10:30~14:48

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会		備考
10:30	佐藤 琢哉	伊藤	原子レンズにおける単ビーム近接場光誘起に関する研究	梶浦	M1構想	
10:42	小林 大介	伊藤	光ポンピングを用いたレーザー冷却原子のスピンの偏極に関する研究	↓	M1構想	
10:54	木田 賢弘	半那	強誘電性を有する液晶性有機半導体の電気特性	佐藤	M1構想	
11:06	小西 昇一	谷・半那	電極から液晶性有機半導体への正孔注入の促進	↓	M1構想	
11:18	佐々木 直人	半那	反応性CVD法による高移動度a-Si TFTの作製	↓	M1構想	
11:30	柳田 高史	半那	フッ素系原料ガスを用いたプラズマCVD法によるPoly-Si薄膜の作製	↓	M1構想	
11:42	休憩					
13:00	小林 由佳	益	マルチスタンダード無線通信回路のための広帯域RF CMOSシンセサイザの検討	佐々木	M1構想	
13:12	宮下 一哉	益	ばらつきを考慮したオンチップ伝送線路配線の研究	↓	M1構想	
13:24	峰山 亜希子	益	ネットワークオンチップのための小面積・低消費電力SerDes回路の研究	↓	M1構想	
13:36	佐渡島 進	益	マルチバンドRF CMOS送信機に関する研究	↓	M1構想	
13:48	植山 寛之	中山・益	トランジスタ特性ばらつき統計学的考察	↓	M1構想	
14:00	休憩					
14:12	梶浦 俊祐	渡辺	Si基板上弗化物系ヘテロ構造を用いたテラヘルツ量子カスケードレーザの研究	峰山	M1構想	
14:24	平澤 亮	渡辺	Si基板上フッ化物系共鳴トンネル構造メモリー素子に関する研究	↓	M1構想	
14:36	鈴木 博之	納富・小山	2次元フォトニック結晶を用いた光伝播制御に関する研究	↓	M1構想	

12月20日(木) B会場(J2棟20階中会議室)10:30~14:12

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会		備考
10:30	須田 雄一郎	大見	スパッタにより形成したSiO ₂ のSBSIプロセスへの応用	田中	M1構想	
10:42	モハマト アヌア	大見	In-situ ECRプロセスによるHfN/HfO _x Ny/Siゲートスタック構造の形成に関する研究	↓	M1構想	
10:54	中川 恭成	筒井	プラズマドーピングで形成した高濃度極浅層における不純物活性状態の研究	須田	M1構想	
11:06	酒井 一憲	筒井	プラズマドーピングによるFin構造へのドーピング特性の研究	↓	M1構想	
11:18	横手 義智	筒井	NiSi ₂ バッファ層を用いた高温成長弗化物共鳴トンネルダイオードの製作	↓	M1構想	
11:30	三浦 圭	筒井	多段集積型弗化物共鳴トンネルダイオードのモノリシック集積化の研究	↓	M1構想	
11:42	休憩					
13:00	守谷 仁	徳光	超低損失SiCパワーMOSFET実現に向けたゲート絶縁膜に関する研究	中川	M1構想	
13:12	大岩 朝洋	徳光	InGaZnO ₄ をチャネルに用いた薄膜トランジスタに関する研究	↓	M1構想	
13:24	近藤 洋平	徳光	Bi _{1.5} Zn _{1.0} Nb _{1.5} O ₇ をゲート絶縁膜に用いた酸化物チャネル薄膜トランジスタに関する研究	↓	M1構想	
13:36	王 冬きょう	石原	Sr ₂ (Ta,Nb)2O ₇ を用いた強誘電体ゲートトランジスタの作製と評価	守谷	M1構想	
13:48	近藤 佑美	石原	2T型強誘電体メモリの作製における最適化と評価	↓	M1構想	
14:00	田中 敬人	石原	有機半導体を用いた強誘電体ゲートFETの作製と評価	↓	M1構想	

12月21日(金) A会場(I2棟3階232号室)10:00~14:32

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会		備考
10:00	野口 浩平	岩井	Effective Work Function Tuning of Ni Silicide by Adding Interfacial Layer for Schottky Barrier Height MOSFET	浦山	M1構想	
10:12	岡本 晃一	岩井	Performance Improvement of Interfacial Layer-Free-MOSFET with La2O3 Insertion	↓	M1構想	
10:24	藤澤 宏樹	岩井	Selection of Metal/High-k Structure for Sub-1 nm with High Thermal Stability	↓	M1構想	
10:36	上村 英之	岩井	Experimental Calibration of Si Nanowires Process and its Electrical Characteristics	↓	M1構想	
10:48	日野 雅文	杉井・岩井	New stress inducing technique for UTBSOI	↓	M1構想	
11:00	休憩					
11:12	高村 陽太	菅原	ハーフメタル・フルホイスラー合金の形成とそのスピン機能MOSFETへの応用に関する研究	上村	M1構想	
11:24	菅原 雄大	宮本	量子構造混晶化を用いた微小化面発光レーザ	↓	M1構想	
11:36	仙石 知行	宮本	有機金属気相成長法による長波長帯GaInNAs系自己形成量子ドットレーザに関する研究	↓	M1構想	
11:48	藤本 康介	宮本	トンネル注入構造を用いた半導体光増幅器に関する研究	↓	M1構想	
12:00	比嘉 康貴	宮本	トンネル注入量子井戸レーザの高性能化に関する研究	↓	M1構想	
12:12	休憩					
13:00	横山 亮	浅田	InPショットキーバリアダイオードを用いたTHz発振素子の線幅測定に関する研究	岡本	M1構想	
13:12	岩橋 洋平	浅田	半導体クライストロン型増幅素子に関する研究	↓	M1構想	
13:24	浦山 健太	浅田	共鳴トンネルダイオードを用いた水平放射型THz発振素子の研究	↓	M1構想	
13:36	寺西 豊志	浅田	共鳴トンネルダイオードの高電流密度化によるTHz発振素子の周波数向上	↓	M1構想	
13:48	休憩					
14:00	山口 達矢	梶川	単一金微粒子と金属ナノギャップ中の光学特性の調査	藤本	M1構想	博士一貫
14:16	幸田 みゆき	岩井	Guideline for Material Design in Defect-Free High-k Gate Dielectric	↓	M1構想	博士一貫

12月21日(金) B会場(I2棟3階234号室)10:00~13:36

開始	氏名	指導教員	発表題目	司会		備考
10:00	馬田 祐輔	小山	周波数変調面発光レーザによる超高速変調に関する研究	内保	M1構想	
10:12	淵田 歩	小山	スローライトを利用した光スイッチに関する研究	↓	M1構想	
10:24	吉田 潤	小山	低群速度光伝搬を用いた非線形位相制御デバイスに関する研究	↓	M1構想	
10:36	中島 純	小山	超精密ナノ加工・インプリント技術を用いた光デバイス製作に関する研究	↓	M1構想	
10:48	休憩					
11:00	吉岡 孝兼	小林	小コア光導波路によるLSI間高密度光接続の研究	馬田	M1構想	
11:12	森 崇嘉	小林・植之原	波長変換を用いた遅延選択可能な光ファイバ遅延線バッファに関する研究	↓	M1構想	
11:24	後藤 研司	小林	全光パケットルーティングのための光スイッチ網の研究	↓	M1構想	
11:36	澤田 憲吾	植之原	光ラベル識別器用半導体光D/A変換器の特性向上に関する研究	↓	M2中間	
11:51	休憩					
13:00	照井 亘瑠	宗片	spin-LASERの作製に向けたIII-V族半導体へのスピン注入	吉岡	M1構想	
13:12	内保 裕一	梶川	FDTD法を利用したナノ構造の電場解析	↓	M1構想	
13:24	伊藤 義貴	梶川	SERSセンサを目指した光ファイバへの金属ナノ構造の構築	↓	M1構想	